

《太赫兹科学与电子信息学报》2024 年第 11 期专栏征稿

主题：宽禁带半导体材料、器件、电路与系统集成

近年来，以 SiC、GaN、金刚石、Ga₂O₃ 为代表的宽禁带半导体在功率、射频器件方面展示出重要的研究价值，并在 5G 通信、汽车电子、快速充电等方面展现出了广阔的应用前景。抓住研发宽禁带功率半导体的战略机遇期，解决宽禁带半导体材料、器件、电路与系统集成中的关键技术瓶颈，具有极为重要的科学意义与实际价值。

为进一步促进宽禁带半导体材料、器件、电路与系统集成等领域的新理论、新技术、新方法的创新研究，促进全国宽禁带半导体行业的相互交流、学习借鉴，《太赫兹科学与电子信息学报》计划推出“宽禁带半导体材料、器件、电路与系统集成”专题栏目，现特向广大专家学者征集符合该专题方向的原创性研究论文及综述，旨在集中反映该领域最新的研究成果及研究进展。

一 征稿范围

- 1) 宽禁带半导体单晶生长
- 2) 宽禁带半导体薄膜外延生长
- 3) 宽禁带半导体器件制备工艺
- 4) 宽禁带半导体功率器件设计与建模
- 5) 宽禁带半导体射频器件技术
- 6) 宽禁带半导体光电器件技术
- 7) 宽禁带半导体电路技术
- 8) 宽禁带半导体系统与集成

二 特邀组稿专家

唐为华 南京邮电大学集成电路科学与工程学院

陈万军 电子科技大学集成电路科学与工程学院

刘斯扬 东南大学集成电路学院

三 专题时间安排

截稿日期：2024 年 9 月 1 日

首轮意见：2024 年 9 月 15 日

录用通知：2024 年 9 月 30 日

出版日期：2024 年 11 月 28 日

四 投稿方式

请登录《太赫兹科学与电子信息学报》官方网站(www.iaeej.com)，根据网站提示在线投稿。投稿时请作者务必在拟投栏目中选择“专栏：宽禁带半导体材料、器件、电路与系统集成”，并附保密审查。投稿模板及要求请参见网站首页。

专栏主编简介



郭宇锋，南京邮电大学党委书记，教授，博士生导师，兼任中国电子学会教育工作委员会副主任委员、中国电子学会电路与系统分会委员。主要从事硅、宽禁带半导体及有机功率与射频集成等研究工作。主持国家级、省部级等项目 20 余项，授权国际专利、国家发明专利 70 余件，发表学术论文 330 余篇，入选国家“万人计划”，江苏省“333 工程”培养人选，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“六大人才高峰”培养对象，获中国电子学会科技进步一等奖、中国产学研合作促进奖等省部级及以上奖项或荣誉 20 项。



唐为华，南京邮电大学教授，博士生导师。在氧化镓及相关方向发表 SCI 论文 300 余篇，引用 13500 多次，H 因子 58，氧化镓薄膜与探测器相关论文国际排名第一；申请授权发明专利 30 余项；主持国家自然科学基金等各类科研项目 20 多项，是“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国科学院“百人计划”专家，曾获北京市科学技术一等奖和北京市自然科学二等奖。氧化镓相关的论文及引用国际排名第一，多篇论文获选 ESI 高被引论文，连续两年被国际著名出版机构 ELSEVIER 评为高被引论文学者(2021, 2022 Most Cited Chinese Researchers)。



陈万军，电子科技大学教授，博士生导师，集成电路科学与工程学院副院长。长期致力于新型功率半导体器件与集成技术领域的科学研究和人才培养工作，主持承担国家科技重大专项、国家自然科学基金、预研重点、瓶颈攻关等国家级/省部级和横向课题 40 余项，在 IEEE EDL、IEEE TED、IEEE TPE 等国际权威期刊和 IEDM、ISPSD 等著名国际会议发表论文 200 余篇，其中 SCI 检索 150 余篇；获授权美国专利、中国发明专利 50 余项；获国家和省部级教学/科研奖 6 项，获中国电子学会先进工作者荣誉称号、CASA 第三代半导体“卓越创新青年”称号等。兼任教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会委员等。



刘斯扬，东南大学教授，博士生导师，国家高层次青年人才、江苏省杰青。主要从事功率半导体器件设计及工艺技术研究，主持国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目 12 项。发表 SCI 论文 103 篇，IEDM、ISPSD 等国际会议论文 17 篇，获美国专利 6 项、日本专利 2 项，中国发明专利 45 项。研究成果获国家技术发明二等奖（排 2）、江苏省科学技术一等奖（排 2）。